

聚焦NEPCON JAPAN 2019 前瞻電子產業研發/製造最新技術趨勢

Focus on NEPCON JAPAN 2019 – The Latest Technology Trends of Advanced Electronic Industry R&D and Manufacturing

何首毅 S.Y. Ho¹、陳凱琪 K. C. Chen²、簡仁德 R. D. Jean²、 范淑櫻 S.Y. Fan³

工研院材化所(MCL/ITRI) ¹副研究員、²研究主任、³材料世界網特派記者

前言

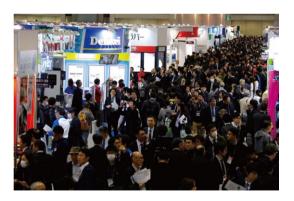
對最具指標性的國際年度產業盛會一第48屆電子研發暨製造綜合展「NEP-CON JAPAN 2019」已於日前圓滿落幕。NEPCON大展延續去年的熱度,在高綜效迴響下,參展廠商遍及37國,參展商數更一舉擴大至2,640家。國際知名企業踴躍亮相,紛紛展示電子產業鏈下的最新技術與設備。為期三天的展會創造了116,000餘人次的觀展人潮,不論展出規模或參觀人數皆再創新高(圖一~圖二)。



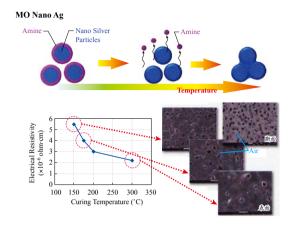
▲圖一 開幕剪綵典禮現場冠蓋雲集,近40家全球重量級大廠共襄盛舉

展期中,人氣熱門的11th Automotive World、全球最大的5th Wearable EXPO,以及3rd RoboDEX與Smart Factory Expo等電子相關展會亦同步登場,為2019年開春掀起熱鬧話題。

今年材料世界網/工業材料雜誌援例邀請工研院内多位技術專家共同赴日,跨領域從不同角度提供深入觀察與第一手資訊。本文將彙整最新技術趨勢,以饗讀者。相關展會系列報導則可於材料世界網(https://www.materialsnet.com.tw) 至費閱覽、下載。



▲圖二 為期三天的展會創造了116,000餘人次的 觀展人潮



▲圖三 Namics高導熱黏晶材料奈米銀燒結機制及SEM切面圖

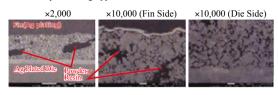
展場巡禮

1. 備受矚目的熱界面材料

根據Yole Développment對全球功率模組市場需求的調查顯示,2015~2020年每年以年均8%左右的成長率成長,預估至2020年市場規模將可達65億美元。隨著功率模組應用越來越廣,且模組體積縮小及整體功率密度的增加,從散熱材料、連接材料至散熱模組的開發皆非常重要。如何有效提高材料散熱效率及降低各界面的熱阻,進而提高整體模組在高溫下的耐受性及可靠度,將左右下世代功率模組的發展。在此次展會當中,許多廠商亦針對散熱議題,發表了相關材料。

Namics以自行合成粒徑大小約100 nm的銀粉混合微米級的銀粉製作出低溫燒結的高導熱黏晶材料,其燒結機制如圖三。以Amine為保護劑的奈米銀粒子,在高溫燒結時,保護劑會揮發,奈米粒子與微米粒子間會燒結成一相,使得粒子間不單單只是接觸,而是如同塊銀一樣,擁有高導熱

· Low-temp. Sintering Type



▲圖四 Namics導熱TIM材料H9890-7不同界面處的截面圖

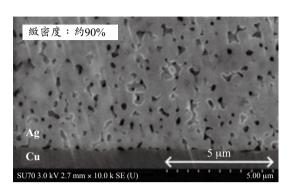


▲圖五 三菱材料燒結銀的樣品

及高導電特性。此外,隨著燒結溫度的提高 (圖三),燒結狀況也越好,電性越佳。

另外,Namics也利用燒結銀,調配高熱傳導的導熱TIM材料。而作為界面材料,連結處的強度非常重要,Namics添加了熱塑性粉體(Elastomer)在裡頭,解決整體的可靠度問題。奈米銀燒結時,會因收縮產生乳洞及收縮應力產生裂痕,孔洞及裂痕的產生,將會使得連接處界面阻抗上升,當添加熱塑型樹脂於配方中,燒結所產生的應力可藉由熱塑型樹脂,達到應力釋放,且熱塑型樹脂於燒結時亦是可流動的,因此也具有填滿孔洞的功能,Namics藉由這樣的設計,提高整體界面的接著力。圖四為該公司發表的導熱TIM材料H9890-7不同界面處(Fin Side & Die Side)的截面圖,圖中黑色處即為熱塑性粉體。

三菱材料公司此次則分別展出了燒結銀、銅的黏晶材料及Core-shell TLP Bonding Material,燒結銀的部分樣品如圖五所示。



▲圖六 燒結銀黏晶材料燒結後的SEM切面圖

1. 低溫脫離保護劑
2. 奈米~次徽米尺寸的粉末粒徑
粉末外觀
加熱後的粒子燃燒

低温脂酶

▲圖七 三菱材料奈米銅燒結後的情況

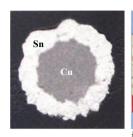
三菱的材料除了可以接合銀和金之外,亦可接合銅界面,此款銀膠的固含量約90 wt%,使用150 nm的銀粒子作為燒結的連接粒子,在大氣下,以10 mm²大小的晶片接合DBC基板,250°C進行燒結,熱導率可達200 W/m·K,接著強度50 MPa,電阻率3.5×10⁻⁶ Ω·cm,為銀金屬電阻率的兩倍,電性相當低。圖六為燒結銀黏晶材料燒結後的SEM切面圖,燒結狀況相當緻密,計算孔隙率約為10%,高緻密度使得不管熱導率或電阻率都可以表現得相當好。

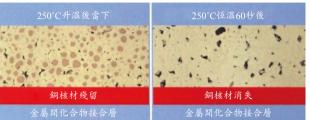
至於燒結銅方面,銅膠固含量約90 wt%,黏度200 Pa·s,使用150 nm的銅粒子作為燒結的連接粒子,接合界面可為金、銀、銅,以10 mm²大小的晶片接著於銅基板上,在氮氣下,以20 MPa,230°C/10 mins的燒結條件,熱導率可達200 W/m·K,接著強度25~50 MPa,電阻率3.5×10⁻⁶ Ω·cm,圖七為奈米銅燒結前後的情況,燒結後,奈米銅已溶融在一起。與其他公司燒結銅的黏晶材料比較可以發現,目前奈米銅若未在還原氣體下燒結,氮氣環境下皆需經由加壓燒結才可以達到緻密的連接層,無壓力燒結的製程可能需要在氫氣下

燒結才可以得到較好的結果。

相對於燒結銀或銅的接合材料,三菱 材料所開發的瞬間液相接合(Transient Liquid Phase Bonding; TLP)材料為另一種相對於奈 米金屬來說,價格較便官,目相關特性較 傳統焊錫材料更佳的方案。瞬間液相接合 材料一般含有A、B兩種金屬,A金屬為高 熔點金屬,B金屬為低熔點金屬。當施加 正向壓力並逐漸升溫加熱至目標溫度TB, TB高於B金屬熔點,B金屬開始融熔,此時 A金屬與B金屬兩者界面間已經開始互相擴 散,因為互相擴散的關係,B金屬熔入A金 屬中,A金屬内因含有B金屬比例增加,導 致熔點降低,融熔狀態的金屬開始擴大, 隨著時間增加,B金屬在A金屬中的濃度降 低,新合金的形成使熔點開始升高,使金 屬間產生接著。

圖八為三菱材料使用自行開發錫、銅核層粒子作為TLP的材料,以含有87%的錫、銅核層粒子,黏度200 Pa·s的膠在氮氣下加壓10 MPa/300°C保持5分鐘,接著強度可達40~60 MPa(接合界面可為鎳、銅、金),熱導率36 W/m·K,電阻率2×10⁻⁵ Ω·cm。圖八可以看到,橘色處為銅,當250°C





透過使用Core-shell構造粉末,能夠迅速形成金屬間化合物,短時間內完成接合



TLP的材料及錫銅核層粒子加熱前後,金屬擴散後之狀況(彩圖請見材料世界網https://www.materialsnet.com.tw)



恆溫60秒後,已無看到兩相金屬的存在, 錫與銅已互相擴散形成 Cu_6Sn_5 及 Cu_3Sn 的合 金結構。TLP材料經 $-40\sim150$ °C冷熱衝擊測 試1,000次,熱阻抗約上升5%,且連接處亦 無裂痕產生。

另一方面,雖然展會中較少看到導電 膠作為線路用途的展示,但仍有較為特別 或特性較佳的相關產品展出,簡述如下。

十条油墨展出包含銀銅膠、開發中的 UV型銀膠及透明導電膜等產品。銀銅膠 的硬刷膜厚約15 μ m,硬化溫度120°C/15 mins,電性約4.5×10⁻⁴ Ω ·cm。銀銅膠相對 於銀膠來說,較不會有銀遷移的情況。透明導電膜以PEDOT:PSS為主的導電油墨,透光率85%,片電阻100~250 Ω / \square ,相對 於商業常用的Heraeus PH1000,片電阻約 800~1,000 Ω / \square ,阻值相當低。UV型的銀膠目前為開發品,並沒有辦法完全使用UV進 行固化,尚需搭配熱硬化達到完全固化。目前的硬化條件如下:曝光能量約750 mJ/

 $\mathrm{cm^2}$,接著熱烘烤80~100°C/30 mins,電性 $\mathrm{2000}$ $\mathrm{2000}$

TOYAL針對導電粉體分別開發出許多 Core-shell粉體,其中粉體核(Core)分別有 銅、鋁、二氧化矽、鎳、氧化鋁:Shell則 是銀。藉由Core的材料差異,賦予粉體較佳的化學安定性、磁性,以及較便宜的價格等。相較於傳統的銀膠,TOYAL以Core-shell的粉體配製銀膠(TCP-LR),TCP-LR以 140° C/30 mins固化後電性為 10^{-4} $\Omega \cdot \text{cm}$,約一般銀膠電性的 $2 \sim 3$ 倍,但在85°C/85%RH、50 V的Migration Test,可以超過1,000小時,為一般銀膠1,000倍以上的時間。

2. 穿戴式裝置的導入應用趨於多元化

近年來,穿戴式裝置的發展在醫護、 運動等應用面都受到相當大的關注。因穿 戴式裝置是穿戴於身體上,必須服貼於不 規則的身體表面,因此可撓性及柔軟性是 必要條件。今年展場中的焦點之一,即是



Suave EL Series伸縮性導電材料 兼具導電性的伸縮丙烯酸彈性體材料

特徵

- ■高伸展性
- ■低楊氏模數
- ■高耐濕熱性 (200°C以下)





用途

- ■彎曲感測器
- ■壓力傳感器
- ■軟性致動器
- ■配線



樣品數值

樣品	楊氏模數 (MPa)	延展性 (%)	體積電阻率 (Ω·cm)
伸縮感測器用途型	2.4	4,500	4.8×10^{0}
低電阻型	3.5	5,000	3.1×10^{-4}

▲圖九 大阪有機化學工業公司展示Suave EL伸縮件導電材料

將穿戴式裝置電極及導線整合於智慧衣上,強調可拉伸性。例如大阪有機化學工業公司展示了一項開發中的伸縮性導電材料「Suave EL系列」,是一項可拉伸的丙烯酸彈性導電材料(圖九),具有高延展性(伸長率可達約5,000%)、低楊氏模數(2~4 MPa)、高耐濕熱性(200°C以下)。

隨著穿戴技術的進展與市場需求發展,穿戴式裝置的導入應用頗具多元化,以下介紹幾個不同的應用。Informatix公司展示GyroEye Holo運用AR技術應用在施工現場。建築工地必須按圖施工,但往往因現場施工限制,而造成很多的不便,發展AR擴增實境眼鏡將可望解決此問題(圖十)。

Kurabo Industries展出智能服裝「Smart-fit」(圖十一),這是一套能為現場工作人員



圖片來源: http://www.informatix-inc.com/gyroeye/holo.html

▲圖十 Informatix展示GyroEye Holo運用AR技術應用在施工現場



圖片來源:https://www.kurabo.co.jp/news/newsrelease/20180524_

▲圖十一 Kurabo Industries公司的智能服裝 Smartfit

進行風險管理支援的系統。運用「Smartfit」可獲取使用者的生理訊息,利用數據分析及AI技術,可進行即時評估並通知在酷熱環境中的工作風險、身體變化狀況等。

此外,穿戴式裝置的目的在於蒐集數據,而蒐集的數據價值在於分析應用。透過追踪使用者的活動、卡路里攝取量和睡眠,穿戴式裝置可協助使用者獲取他們的飲食和活動習慣,並對此一健康相關數據作分析,進而建議調整生活習慣,期望有助於個人的健康。在一項專題演講中,Fit-



圖片來源: https://japanese.engadget.com/2019/01/20/5-expo/

▲圖十二 FDK公司展示的薄形鋰離子電池外觀

bit公司即強調下一步將為更多的生醫級生 理訊號資訊及數據分析導入更多機器學習 及AI技術,以作為健康促進之應用。

電力供應也是穿戴式裝置不可或缺的 項目,缺少了電源供應或電源供應不足, 穿戴元件將難以運作。為了搭配穿戴式裝 置,薄形化是電力供應的必要條件。電子 零組件廠商FDK展示厚度如紙張般的鋰離 子電池(圖十二),厚度如一般名片,具重 量輕、體積小之特性,且在低溫的寒帶地 區也可有額定輸出。

南韓JENAX公司展示「J.Flex」可撓鋰 高分子電池(圖十三),不僅可以彎曲、捲 繞,在有破損的情況下,也不會產生爆炸或 著火,即使將電池剪開,仍可以維持運作。

另一方面,全固態電池被視為是下一 代電池發展的主流方向。日本市調機構富 士經濟在一項全球次世代電池市場報告中 即提及,2017年全固態電池的市場規模為 21億日圓,並預測2035年將可望達到2兆 7,877億日圓。此外,日本新能源產業技術 總合開發機構(NEDO)亦已與豐田汽車、Pa-





圖片來源: https://japanese.engadget.com/2019/01/20/5-expo/

▲圖十三 JENAX可撓電池,剪斷的電池電量仍 可運作

nasonic等23家企業、東京工業大學等15家 研究機構共同投入了「全固態電池」的開發 事業,預計投入總事業經費達100億日圓。 日本積極透過產官學研攜手合作,以全日 本之力推動次世代電池之研發。

FDK在此次展會中即展出了一項世界 最高水準之高電壓且超小型的氧化物類全 固態電池(圖十四~圖十五),尺寸為4.0 mm × 2.0 mm × 2.0 mm, 標稱電壓為3 V, 額定電流20 μA,標稱容量140 μAh,質量 僅0.05克,可使用於-20~105°C的溫度環境 下,適用溫度範圍廣。由於具有超小型、 對應表面貼裝器件(Surface Mounted Devices)、高電壓、高容量、高能量密度、高 安全性、高環境適合性等特點,將可望應 用於物聯網(IoT)裝置、穿戴式裝置、實時 時鐘(Real-time Clock)、微控制器(MCU)/靜 態隨機存取記憶體(SRAM)等半導體製品用 途,或是作為在高溫、真空等嚴苛使用環 境下使用之產業機器、車載電裝品測定、 無線模組的備用電源。

另一方面,積水化學則展出了可促進 電極低電阻化、長壽命化之高性能導電助 劑「邊緣剝離石墨(Edge Exfoliated Graphite; EExG)」(圖十六)。透過邊緣剝離,實現了



▲圖十四 FDK超小型氧化物 類全固態電池

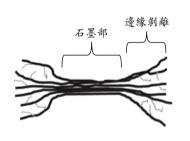


▲圖十五 FDK超小型氧化物 類全固態電池基板構裝



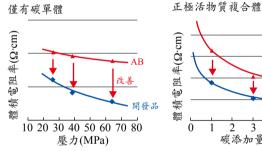
▲圖十六 積水化學開發的邊 緣剝離石墨(EExG)

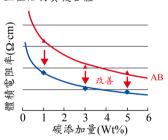
構造示意圖



· 透過邊緣剝離,實現了EExG高表面積化

粉體電阻





• 透過少量添加,達成低電阻化

▲圖十七 透過邊緣剝離,實現了EExG高表面積化

高表面積化,且即使少量添加,亦可達成 低電阻化(圖十七)。

再者,在智慧工廠展覽部分則是強調 大數據分析應用及AI導入,以提高診斷預 測的準確度。工業製造運用物聯網、機器 人等創新技術的持續發展,導致如何提升 產品品質穩定度與設備故障預測技術的需 求越來越重要。ISID公司即展示了故障預測 技術「PDX大數據分析平台」,致力於設備 故障的預防診斷(圖十八)。Panasonic則是 以諧波感測器和AI進行設備診斷服務,減 少突然的設備故障及維修費用。它是一項 對設備狀態進行監測之服務,量測所得之 諧波數據會被傳送到雲端,透過AI判斷設 備狀況是否正常。

研討會重點分享 Fan-out WLP技術發展趨勢

2019年的NEPCON JAPAN與往年一 樣,除了豐富多元的展覽外,同時也舉辦 了探討時下最新技術的研討會論壇。以下 將介紹目前正夯的Fan-out WLP技術發展和



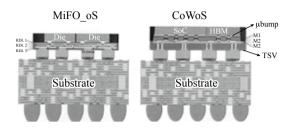
▲圖十八 ISID大數據分析平台「PDX」

5G技術所需之相關構裝技術趨勢。

針對Fan-out WLP,TechSearch顧問公司指出,在目前競爭激烈的衆多廠商中,台灣的ASE、PTI、TSMC、Unimicron都在其中扮演重要角色。TechSearch認為,未來的Fan-out WLP是多種構裝型態、百家爭鳴的狀態,誰能提供多元的構裝,並提高產能(Yield)就能在這戰場中取得一席之地。不僅是晶圓構裝尺寸、大面積的Panel Level Package尺寸從370 mm × 470 mm到600 mm × 600 mm都有開發的需求。

TSMC今年也與會分享Fan-out的構裝技術。TSMC的InFO WLP因具有較薄的RDL、細線路設計(Fine Pitch Cu),能提供訊號傳遞、降低雜訊,並且降低熱損失效應。除了現有的InFO WLP,他們朝向多晶片(Multichip)構裝持續開發,高密度的構裝Pitch約在60~80 μm,RDL L/S為2 μm/2 μm。講者特別提到,在多晶片構裝結構中,Underfill 封裝材料在晶片(Chip)與模封材料(Epoxy Molding Compound)扮演著緩衝的角色(Buffer Layer),能有效降低應力、提升信賴性。

日立化成公司則分享Fan-out Package相



▲圖十九 聯發科MiFO-oS與CoWoS構裝比較

關的材料技術。日立化成於東京近郊成立一研發中心,建立提供構裝材料相關的驗證平台,該中心能提供模擬、測試載具設計、材料配方開發、構裝製程評估、信賴性測試與分析。該中心能完整的扮演串接材料設計與構裝技術需求的橋樑,不僅提供構裝廠所需的材料技術,也能提供材料開發者正確的材料設計開發方向、縮短研發時程。除了建置FO WLP測試載具,也同步建立Panel Level的測試載具。

因應5G新時代來臨之際,另有論壇探討了最新的半導體構裝相關技術。SoftBank以淺顯易懂的論述說明我們所處的時代:過去使用3G時,我們的手機提供了行動中的聲音傳遞;現在所處的4G時代,我們的行動裝置不僅傳遞聲音,亦能進行包括郵件、影音下載等資料的傳輸;而即將到來的5G則會提供一個全方位的服務網絡,也就是目前我們所說的V2X (Vehicle to Everything),同時也是AI與IoT的結合。

另外,聯發科亦發表5G應用的新構裝 技術與技術發展趨勢,並用另一種方式來說 明5G時代對我們的影響。目前使用4G網絡 下載一部約兩小時的電影約需6分鐘,而未 來5G下載同樣的內容卻僅需要3.6秒。由此 可見,5G時代將是數據蓬勃發展的時代,



▲圖廿 主辦NEPCON JAPAN的Reed Exhibitions Japan事務局長前薗雄飛歡迎各界前來參與國際年度電子產業盛會

要能應付如此高速的傳輸,一定要新的構裝型態才能滿足需要的技術。在5G應用中的重要伙伴即是AiP (Antenna in Package),聯發科的AiP技術發展由Antenna on PCB朝向Antenna in Module,再朝向現在開發的Antenna in Package發展。在毫米波傳輸過程中,對材料的要求也越來越嚴苛,為了不使訊號在高頻傳輸過程中產生訊號損失,低介電特性(Low D_k 、Low D_f)的基板材料是現下亟需的技術。目前聯發科開發的頻率在10 GHz,未來則將朝向77 GHz發展。

聯發科在高密度構裝需求下開發MiFOoS的構裝技術(圖十九),它沒有Microbump,也不需要TSV,不僅維持優異的電氣特性,也較CoWoS的構裝結構更有成本優勢。MiFOoS為高密度構裝型態,晶片I/Os大於2,000,RDL的L/S為2 μm/2 μm,構裝尺寸大於50 mm × 50 mm。該公司的Fanout構裝技術分別應用在主/被動元件PMIC/RF模組構裝、Antenna in Package以及多晶片整

合構裝。未來聯發科將持續努力為即將到來的5G時代提供新的、多元的構裝技術。

2020年NEPCON JAPAN與 Wearable EXPO將分兩梯次舉行

規模日益擴大的NEPCON大展多年來總在每年年初帶給相關業界諸多收獲。根據主辦方Reed Exhibition Japan事務局長前菌雄飛(圖廿)說明,為響應日本中部地區的業界需求,去年9月首度新增一場,並移師至工業重鎭名古屋市舉辦,且獲得各界一致好評。因此,今年已決定於9月18~20日舉辦第2屆NEPCON JAPAN名古屋大展,目前預計將有750家企業參與展出。

經過多年的耕耘, NEPCON JAPAN不 僅已成為廠商展示產業實力的最佳平台, 同時也是最新科技、技術與產品的重要交 流平台。綜合性的策展規劃與五大展會連 動的作法在全球更是絕無僅有,不僅能為 參展廠商與觀展人士帶來複合性效益,同 時也能從產業界展出動態一窺未來發展趨 勢。前薗事務局長表示,未來NEPCON JAPAN仍將持續招攬更多來自全球各國的 重量級廠商前來共襄盛舉。此外,對於明 年度的策展規劃,由於2020年適逢日本東 京舉辦奧運,Tokyo Big Sight場地使用將有 所侷限,因此展出時間與内容將調整:電 子研發暨製造綜合展「NEPCON JAPAN」與 汽車技術博覽會(Automotive World)維持在 1月舉辦;而智慧工廠博覽會(Smart Factory Expo)、可穿戴式設備暨技術博覽會(Wearable EXPO)、機器人開發活用展(RoboDEX) 等則將更改至2020年2月舉行。展出規模同 樣盛大、内容豐富多元可期,歡迎各界前 來參與這場國際年度產業盛會。₩